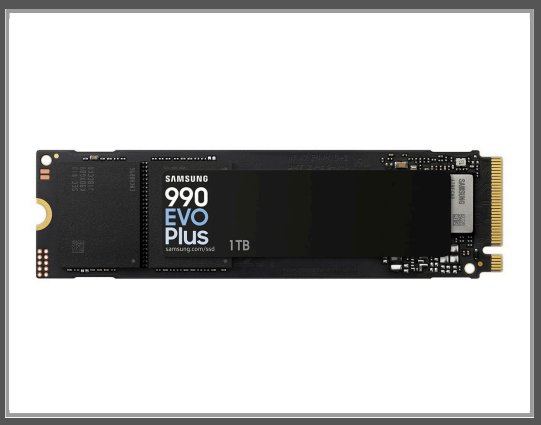
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 5.0 x2 (NVMe)

256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0



Gruppe	SSDs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	MZ-V9S1T0BW
EAN/UPC	8806095575674

Beschreibung

Die Samsung 990 EVO Plus ist ein internes Solid State-Laufwerk, das für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer robusten Kapazität von 1 TB bietet sie reichlich Speicherplatz für eine Vielzahl von Dateien und Anwendungen. Das Laufwerk nutzt PCI Express 5.0 und bietet interne Datenraten von bis zu 7150 MB/s, was einen schnellen Datenabruf und minimale Ladezeiten ermöglicht. Die V-NAND TLC-Technologie von Samsung verbessert die Leistung und Ausdauer, so dass sie sich sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für intensive Aufgaben eignet. Dieses Laufwerk ist so konzipiert, dass es einer Reihe von Umgebungsbedingungen standhält. Es arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0°C bis 70°C und widersteht Lagertemperaturen von -40°C bis 85°C. Es bietet TRIM-Unterstützung und einen Auto Garbage Collection Algorithmus, der eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Die Sicherheit wird durch die Hardwareverschlüsselung und die Konformität mit TCG Opal Encryption 2.0 priorisiert, wodurch die Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0 - SSD - 1 TB - PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Merkmale	Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm
Gewicht	9 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	1 TB

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Merkmale	Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667
Breite	22.15 mm
Tiefe	80.15 mm
Höhe	2.38 mm
Gewicht	9 g
	Leistung
Interner Datendurchsatz	7150 MBps (lesen)/ 6300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write	1350000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	850000 IOPS
	Zuverlässigkeit
MTBF	1.500.000 Stunden
	Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
	Stromversorgung
Energieverbrauch	4.3 Watt (Lesen) 4.2 Watt (Schreiben) 60 mW (Standby) 5 mW (Sleep-Modus)
	Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen	Samsung Magician Software
	Verschiedenes
Gehäusematerial	Nickelbeschichtung
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 600 TBW
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	20 g @ 20-2000 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.